



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XT551N

瞬态电压抑制 (TVS) 二极管

文件编号 临时

版本号 18-A3-06

页码 1/2

1 主要用途与主要特点

1.1 主要用途

用 W1XT551N 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

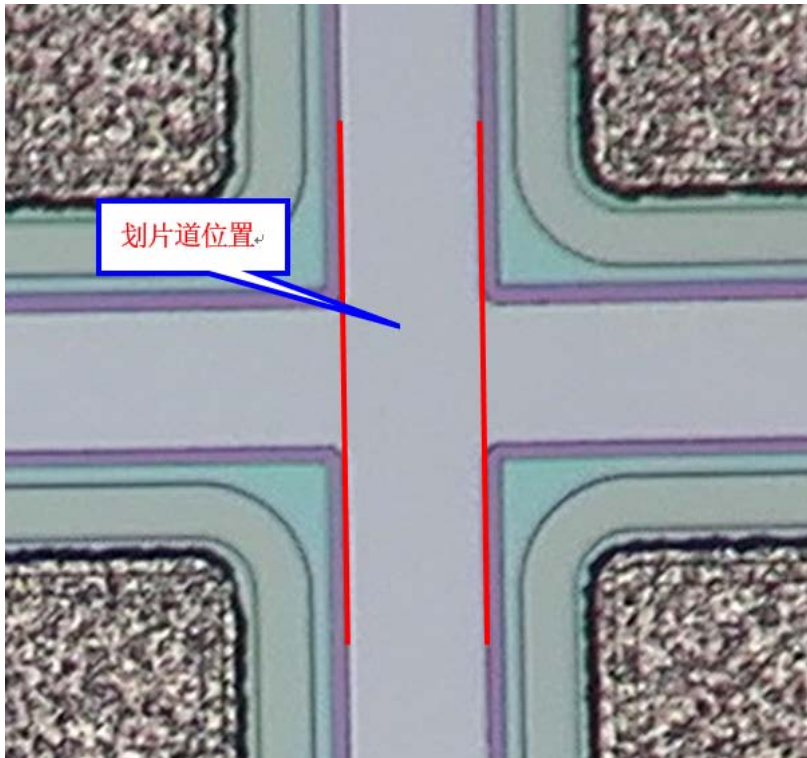
1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.4×0.4		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	≤170		
	划片道*尺寸 (μm)	45		
	键合区面积 (μm ²)	正面	168×168	
	正面电极	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极	表层金	银	金
		装片要求 (推荐)	低温共晶	共晶
	硅片直径 (mm)	φ 125		
	键合要求 (推荐)	铜丝; φ 32 μm; 2 根		

* 划片道位置示意图:



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XT551N	文件编号	临时
	瞬态电压抑制 (TVS) 二极管	版本号	18-A3-06
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: 推荐成品:
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R = \pm 1\text{mA}$	4.5		6.5	V
反向电流	I_R	$V_R = \pm 3\text{V}$	—	—	1	μA
结电容	C_{tot}	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	40	—	pF
峰值电压	V_C	$I_{PP} = \pm 25\text{A} (8 \times 20 \mu\text{s})$	—	—	20	V

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532